

**ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОПРОВОДИМОСТИ
АМОРФНОГО ГИДРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ
МЕТОДОМ ВИДИКОНА**

Голикова О. А., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Захарова Н. Б.,
Ятлинко И. И., Петров И. Н.

В [1] сообщалось о создании мишней видикона на основе аморфного гидрированного кремния ($a\text{-Si} : \text{H}$) и о результатах исследования их спектральных и люкс-амперных характеристик. Мишени имели структуру вида $n^+ - a\text{-Si} : \text{H}$, $i - a\text{-Si} : \text{H}$, Sb_2S_3 , где $n^+ - a\text{-Si} : \text{H}$ и Sb_2S_3 ($d=100$ нм) — блокирующие слои, $i - a\text{-Si} : \text{H}$ ($d_i=500-1000$ нм) — активный слой. При этом как $n^+ - a$ -, так и $i - a\text{-Si} : \text{H}$ с заданными свойствами получали в триодной системе ВЧ разложение силаногелиевой газовой смеси без добавления в нее фосфина или диборана. В результате оптимизации свойств n^+ -слоя удалось достигнуть низких величин темнового тока (I_t) (рис. 1), однако свойства i -слоя первоначально не были

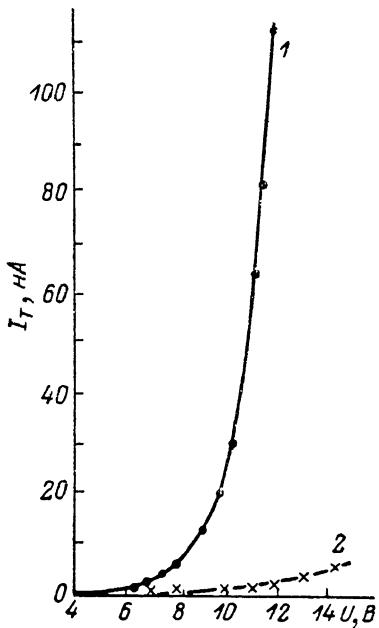


Рис. 1. Темновой ток мишени.
1 — без n^+ -слоя, 2 — с оптимизированным n^+ -слоем

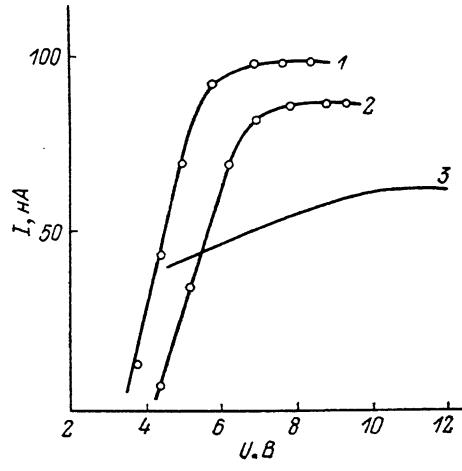


Рис. 2. ВАХ мишней ($\Phi=0.5$ лк, белый свет, $d_i=600$ нм).
1, 2 — по данным настоящей работы, 3 — для мишени, описанной в [1].

оптимизированы. Действительно, величины плотности состояний на уровне Ферми были $g(\epsilon_F)=10^{16}-10^{17}$ эВ $^{-1}\cdot\text{см}^{-3}$, а на расстоянии $\epsilon_i=0.5-0.6$ эВ от края v -зоны — $g(\epsilon_i)\simeq 10^{18}$ эВ $^{-1}\cdot\text{см}^{-3}$ [2]. Соответственно величина удельного сдвига дырок для этого слоя равна $(\mu\tau)_p\simeq 10^{-10}$ см $^2/\text{В}$ [3], т. е. слишком низкая. На рис. 2 приведена световая вольт-амперная характеристика (ВАХ) такой мишени.

В настоящей работе были исследованы мишени с i -слоем, энергия активации темновой проводимости которого $\Delta E=1$ эВ, т. е. ϵ_F при $T=0$ находится в середине E_g ($E_g^{\text{out}}=2$ эВ). Как известно, в нелегированном $a\text{-Si} : \text{H}$ ϵ_F обычно сдвинут в сторону ϵ_c (края c -зоны): $\Delta E=0.6-0.8$ эВ, а сдвиг ϵ_F к середине E_g и соответствующий рост $(\mu\tau)_p$ достигаются в результате легирования бором. Сдвиг ϵ_F достигнут без специального легирования, по-видимому, за счет снижения величины $g(\epsilon_i)$ при $\epsilon_i=0.5-0.6$ эВ. Действительно, величина $g(\epsilon_i)$, определенная методом, описанным в [2], $\sim 10^{17}$ эВ $^{-1}\cdot\text{см}^{-3}$, т. е. на порядок ниже, чем получалась ранее. Величина $g(\epsilon_F)$ при этом $10^{15}-10^{16}$ эВ $^{-1}\cdot\text{см}^{-3}$. Такой материал рассматривается нами как оптимальный для создания i -слоя мишени.

Согласно результатам времязадерживающих экспериментов, для таких слоев $(\mu\tau) \approx (\mu\tau)_p = 5 \cdot 10^{-9} \text{ см}^2/\text{В}$. Полагая, что равенство $(\mu\tau)_p \approx (\mu\tau)$ справедливо и в стационарном состоянии, из экспериментальной величины стационарной фотопроводимости при $\Delta E = 1$ эВ [3] имеем $(\mu\tau)_p = 5 \cdot 10^{-8} \text{ см}^2/\text{В}$. Квазистационарную фотопроводимость мишени видикона (время пролета дырок $\sim 10^{-6}$ с, время считывания сигнала $4 \cdot 10^{-2}$ с), очевидно, ограничивает некоторая промежуточная величина $(\mu\tau)_p$. Таким образом, для данного случая $5 \cdot 10^{-9} \leq (\mu\tau)_p \leq 5 \times 10^{-8} \text{ см}^2/\text{В}$.

На рис. 2 приведены ВАХ двух мишеней при освещении белым светом, когда вклад в фототок дают не только дырки, но и электроны. Однако начало области насыщения фототока при освещении мишени светом $\lambda = 417$ нм, когда ток можно считать исключительно дырочным [2], фактически совпадает с показанным на рис. 2. Поэтому можно считать, что и в рабочих условиях мишени вклад дырок преобладает. Этого нельзя было сказать об исследованных ранее мишенях, у которых дырочный ток не насыщался вплоть до напряжения на мишени 15 В [2], в то время как ток при освещении белым светом выходит на насыщение (рис. 2). Для мишеней, исследованных в настоящей работе, по началу насыщения ВАХ, когда $(\mu\tau)_p E \gg d$, (E — напряженность электрического поля), можно оценить $(\mu\tau)_p \gg 10^{-9} \text{ см}^2/\text{В}$. Это согласуется с результатом оценки $(\mu\tau)_p$, приведенным выше. Указанные величины удельного сдвига дырок должны обеспечивать низкие величины фотоэлектрической составляющей инерционности видикона. Отметим также, что насыщение фототока наступает при полях ниже 10^5 В/см, когда величины темнового тока малы (рис. 1) и он не может ограничивать ток сигнала прибора. Кроме того, при таких полях еще не появляются «белые пятна» на мишени за счет локальных пробоев.

Из рис. 2 следует, что чувствительность мишени составляет максимально $S = 2000 \text{ мкА/лм}$ (площадь сканирования мишени электронным лучом $\sim 1 \text{ см}^2$). Согласно [4], такая величина мишени на основе $a\text{-Si : H}$ соответствует квантовой эффективности во всем видимом диапазоне, близкой к 100 %.

Список литературы

- [1] Голикова О. А., Мездрагина М. М., Петров И. Н., Казанин М. М., Сорокина К. Л. // Письма ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 4. С. 85—87.
- [2] Голикова О. А., Заец А. И., Казанин М. М., Петров И. Н. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 4. С. 768—771.
- [3] Голикова О. А., Бабахаджаев У. С., Казанин М. М., Мездрагина М. М., Арлаускас К., Юшка Г. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 7. С. 1190—1193.
- [4] Nesladek M., Kočka J., Vanček M., Stuchlík J., Stíka O., Dlouhý J., Sipek E., Jedlička M. // J. Non-Cryst. Sol. 1987. V. 90. P. 251—254.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получено 18.06.1990
Принято к печати 21.06.1990

ФТП, том 25, вып. 1, 1991

ФОТОСТИМУЛИРОВАННОЕ НЕЧЕТНОЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКА ПРИ РАССЕЯНИИ ЭЛЕКТРОНОВ ЗАРЯЖЕННЫМИ ПРИМЕСЯМИ

Железняк А. Т., Шмелев Г. М.

Теории поперечного магнитосопротивления (МС) полупроводника, находящегося в сильном линейно поляризованном ВЧ электрическом поле, посвящено немало работ (см. обзор в [1]). Интерес к этому вопросу вызывается, в частности, тем, что такое фотостимулированное (ФС) МС содержит и члены, нечетные по магнитному полю (Н). Это важное обстоятельство отражает нарушение